



2SB709A (3CG709A)

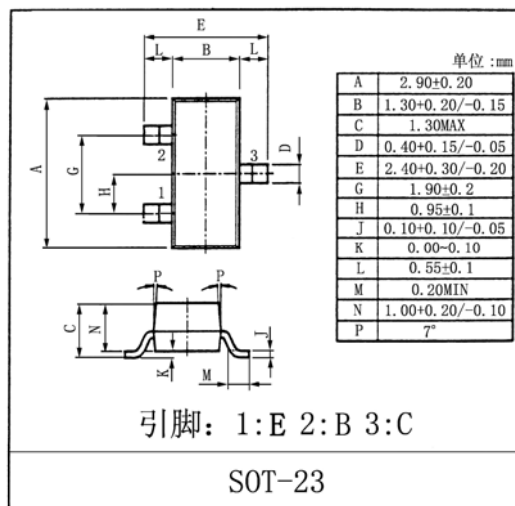
硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于普通功率放大/Purpose: General power amplifier applications.

特点:与 2SD601A(3DG601A) 互补/Features:Complementary pair with 2SD601A(3DG601A).

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	-45	V
V_{CEO}	-45	V
V_{EBO}	-7.0	V
I_C	-100	mA
I_{CP}	-200	mA
P_C	200	mW
T_j	150	°C
T_{stg}	-55~150	°C



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CBO}	$I_C = -10 \mu A$	$I_E = 0$	-45			V
V_{CEO}	$I_C = -2mA$	$I_B = 0$	-45			V
V_{EBO}	$I_E = -10 \mu A$	$I_C = 0$	-7			V
I_{CBO}	$V_{CB} = -20V$	$I_E = 0$			-0.1	μA
I_{CEO}	$V_{CE} = -10V$	$I_B = 0$			-100	μA
h_{FE}	$V_{CE} = -10V$	$I_C = -2mA$	160		460	
$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100mA$	$I_B = -10mA$		-0.3	-0.5	V
f_T	$V_{CB} = -10V$	$I_C = -1mA$		80		MHz
C_{ob}	$V_{CB} = -10V$	$I_E = 0$		2.7		pF

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	Q	R	S
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	160-260	210-340	290-460
印章 Marking	H1BQ	H1BR	H1BS



2SB709A (3CG709A)

